

# Isolanti e conduttori

In qualsiasi materiale:

## cariche elettriche

In genere, +ve + -ve

Classificazione tradizionale:

*isolanti* - *cariche fisse*

*conduttori* - *cariche libere di muoversi*

*(semiconduttori)*

*(superconduttori)*

Origine delle differenze:

*diverse proprietà atomiche/molecolari*

*legame chimico*

*struttura cristallina (solidi)*

Comprensione: meccanica quantistica

# Proprieta' dei conduttori

$$\mathbf{E}_{int} = 0$$

$$\rho_{int} = 0$$

*cariche solo su superficie*

*sup. conduttore e' equipotenziale*

*$\mathbf{E}$  ortogonale a superficie*

$$\mathbf{E}_{ext} = \sigma / \epsilon_0 \mathbf{n}$$

Tutte legate alla presenza di cariche libere

# Interpretazione-1

1)  $\mathbf{E}=0$  all'interno del conduttore

Nel conduttore ci sono cariche libere

Se all'interno  $\mathbf{E} \neq 0$ , le cariche sarebbero in moto, quindi fuori dall'equilibrio.

Quindi:  $\mathbf{E}=0$  per un conduttore in equilibrio

2)  $\rho=0$  all'interno del conduttore

vedi 1): usiamo il teorema di Gauss



Sup. gaussiana a  
distanza infinitesima da  
quella del conduttore

$$\mathbf{E} = 0 \rightarrow \oint (\mathbf{E}) = 0 \rightarrow q_{\text{int}} = 0$$

3) cariche solo su superficie

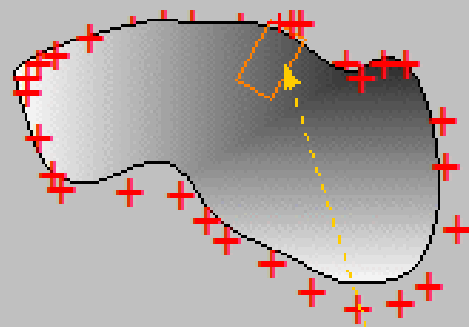
vedi 2): se carichiamo un conduttore, la carica si distribuisce solo sulla superficie

## Interpretazione - 2

### 4) Superficie conduttore: equipotenziale

Se non lo fosse, ci sarebbero dei gradienti di potenziale, quindi dei campi elettrici superficiali che causerebbero il moto delle cariche, quindi non ci sarebbe equilibrio

### 5) C.elettrico: ortogonale alla superficie



$$\Phi(\mathbf{E}) = \oiint_{\substack{\text{superficie} \\ \text{cilindro}}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} \approx E_{\text{sup}} \Delta S = \frac{\Delta Q}{\epsilon_0}$$

$$\Delta Q = \sigma \Delta S$$

$$\rightarrow E_{\text{sup}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Sup. gaussiana: *cilindro*

Base superiore a distanza infinitesima da quella del conduttore

# Effetti vari per i conduttori

## 1) Potere delle punte

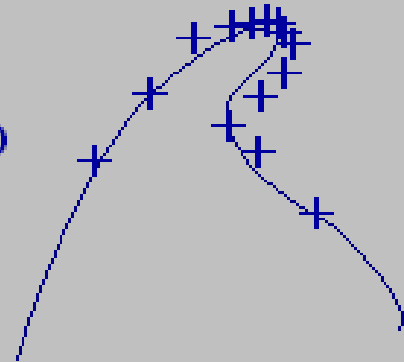
Raggio di curvatura piccolo

Gradiente di  $V$  grande

$E$  grande

$\sigma$  grande

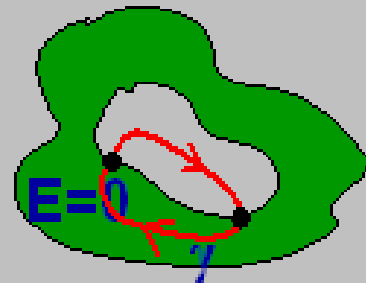
Quindi: carica concentrata vicino alle punte



## 2) Schermo elettrostatico

Conduttore cavo:  $E = 0$  nella cavita' e sulla parete interna

Altrimenti  $\oint_{\gamma} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} \neq 0$

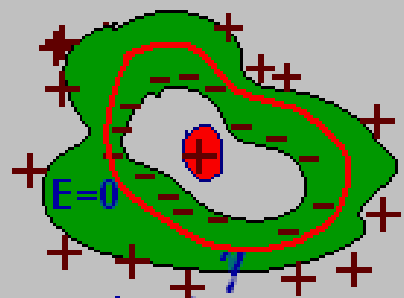


## 3) Carica entro cavita'

Carica indotta su parete interna - uguale, opposta

Carica indotta anche su

parete esterna - opposta (cons. carica)



## Capacita' di un conduttore

Rapporto fra carica e potenziale:

$$C = \frac{Q}{V}$$

Legata alla geometria del conduttore e alla sua posizione rispetto agli altri

Analogia con gas perfetto:

$$pV = nRT \rightarrow \frac{n}{p} \rightarrow \left( \frac{V}{RT} \right)$$

analogo a C

Unita' di misura:

$$[C] = [Q][V^{-1}] \rightarrow \text{unita'} = 1 \text{ CV}^{-1} = 1 \text{ F (farad)}$$

# Capacita' di una sfera

Sfera conduttrice isolata:

*campo interno nullo*

*campo esterno come c.puntiforme*

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} \quad r \geq R$$

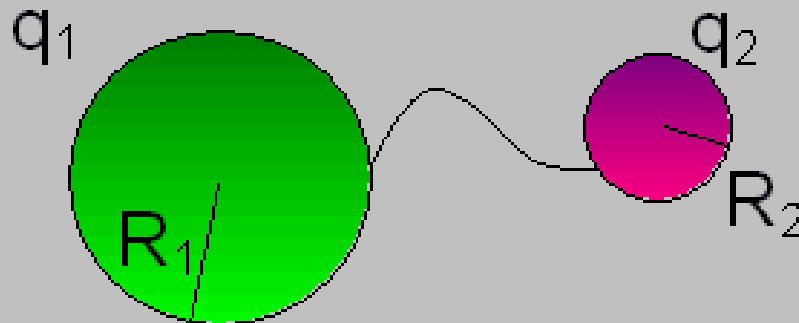
$$V = \text{cost} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R} \quad r < R$$

Allora per la capacita':

$$C = \frac{Q}{V(r=R)} = 4\pi\epsilon_0 R$$

Es: R=0.1 m	C=11 pF
R=6.7 10 <sup>6</sup> m	C=0.74 mF
R=9 10 <sup>9</sup> m	C=1 F

# Due sfere collegate



Collegate: unico conduttore  $V_1 = V_2$

$$\frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} = \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} \rightarrow \frac{q_1}{q_2} = \frac{C_1}{C_2}$$

$$\rightarrow q_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (q_1 + q_2), q_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} (q_1 + q_2)$$

$$\rightarrow \sigma_1 = \frac{q_1}{4\pi R_1^2} = \frac{\frac{R_1}{R_1 + R_2} (q_1 + q_2)}{4\pi R_1^2}, \sigma_2 = \frac{\frac{R_2}{R_1 + R_2} (q_1 + q_2)}{4\pi R_2^2}$$

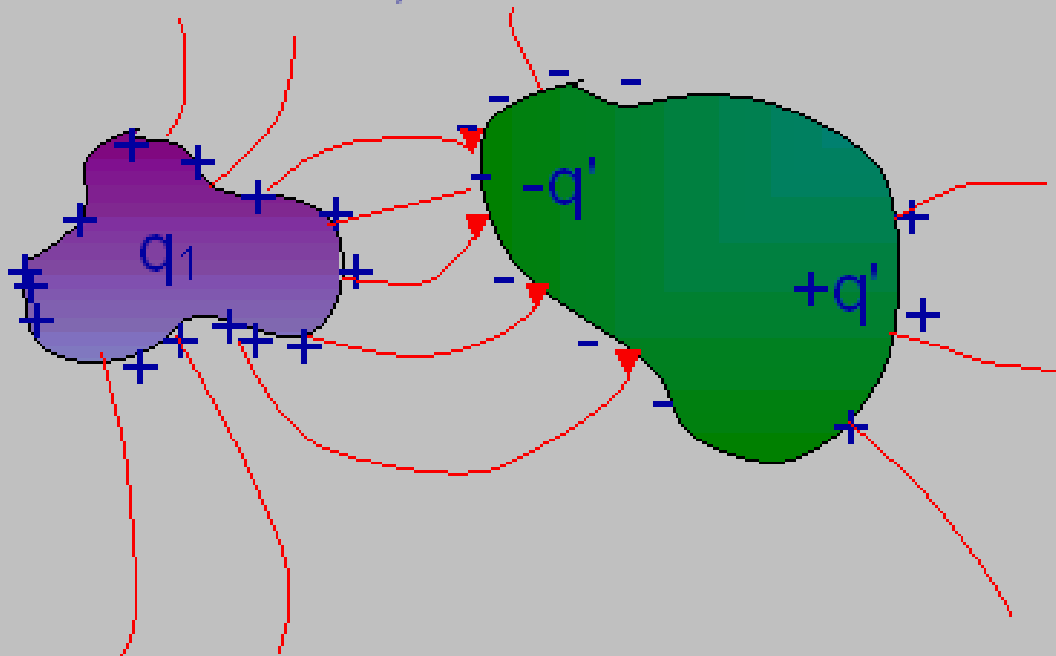
$$\rightarrow \frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{E_1}{E_2}$$

Potere delle punte...



## Sistemi di conduttori

Coppia di conduttori:  
1 carico, 2 scarico



Effetto dell'induzione elettrostatica:

$V_1 \rightarrow V'_1$  quando si introduce 2

$V_1$  (in assenza di 2) risente solo di  $q_1$

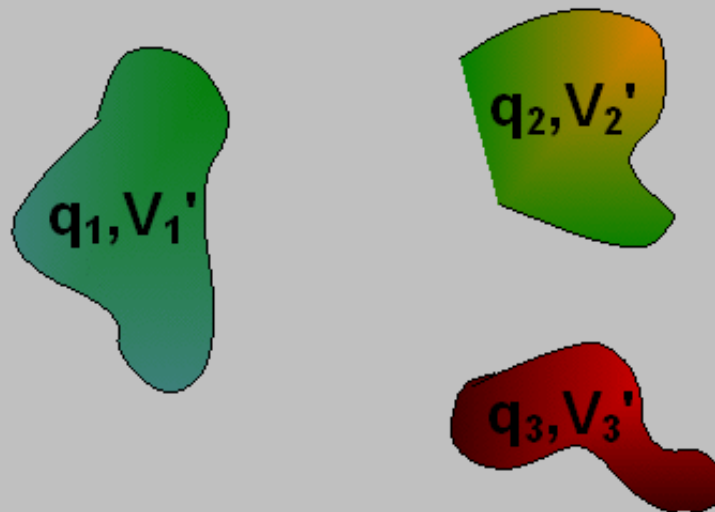
$V'_1$  (in presenza di 2) risente di  $q_1$ ,  $-q'$  e  $+q'$

$V'_1 < V_1$  perche'  $-q'$  e' vicina,  $+q'$  lontana

$C \rightarrow C' > C$ : infatti  $C' = \frac{q_1}{V'_1}$

## Sistema di conduttori

Ognuno con propria carica  $q_1, q_2, \dots$



Induzione elettrostatica: effetto "molti corpi"

*Ogni conduttore induce cariche su tutti gli altri*

*Inoltre, ogni conduttore ha sua propria carica*

Quindi, il potenziale di ogni conduttore è:

$$V_1' = a_{11}q_1 + a_{12}q_2 + \dots$$

$$V_2' = a_{21}q_1 + a_{22}q_2 + \dots$$

.....

Matrice di coefficienti: invertibile

$$q_1 = c_{11}V_1' + c_{12}V_2' + \dots$$

$$q_2 = c_{21}V_1' + c_{22}V_2' + \dots$$

.....

Matrice delle capacità mutue

# Condensatore

Proprieta' matrice capacita':

$$c_{ij} = c_{ji} \leq 0 \quad i \neq j$$

$$c_{ii} > 0 \quad i = j$$

Coppia di conduttori con  
*cariche proprie uguali e opposte*  
*induzione completa*

$$q_1 = -q_2 = q$$

$$\rightarrow \begin{cases} V_1 = a_{11}q - a_{12}q \\ V_2 = a_{21}q - a_{22}q \end{cases}$$

$$\rightarrow V_1 - V_2 = (a_{11} + a_{22} - 2a_{12})q$$

$$\rightarrow C = \frac{q}{V_1 - V_2} = \frac{1}{a_{11} + a_{22} - 2a_{12}}$$

Capacita' del condensatore

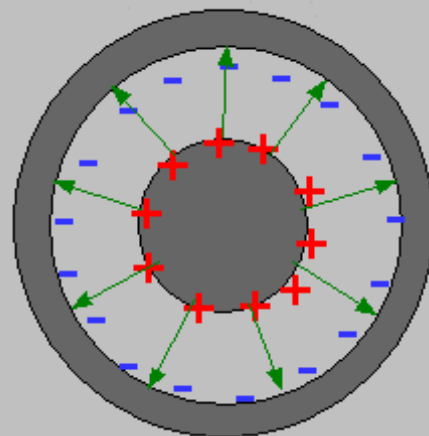
# Condensatore

Sistema di 2 conduttori fra i quali esiste *induzione completa*:

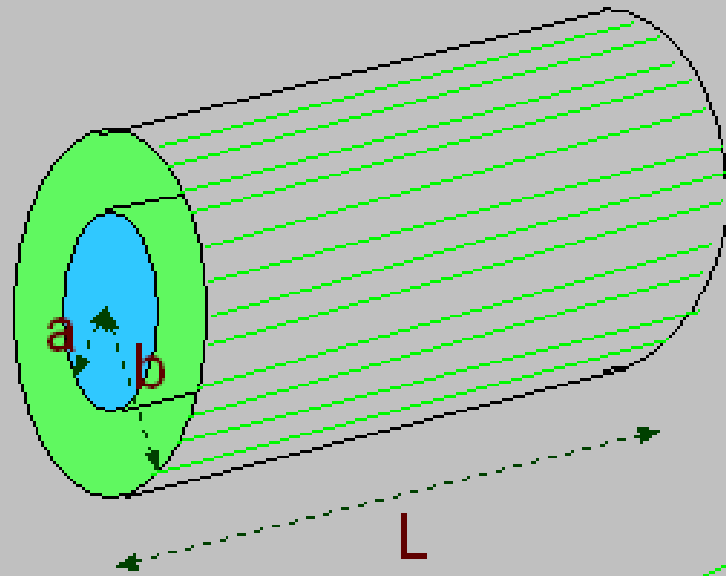
*Tutte le linee di forza che escono da 1 finiscono su 2*

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

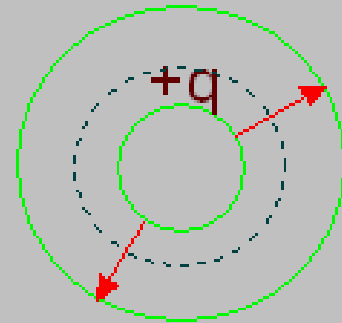
Esempio:  
*cilindri coassiali*



## Condensatore cilindrico



Sup. gaussiana coassiale ai cilindri:

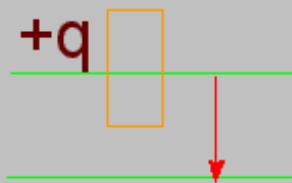
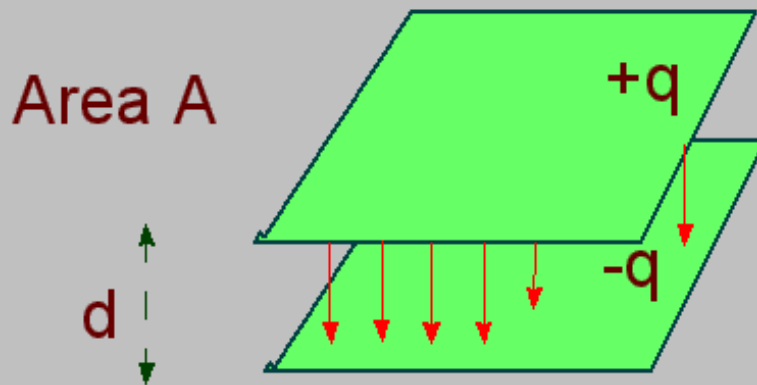


$$\Phi(\mathbf{E}) = 2\pi r L E = \frac{q}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{q}{2\pi r L \epsilon_0}$$

$$V = \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{q}{2\pi L \epsilon_0} \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{q}{2\pi L \epsilon_0} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$\rightarrow C = \frac{q}{V} = \frac{2\pi L \epsilon_0}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

# Condensatore piano



Sup. gaussiana

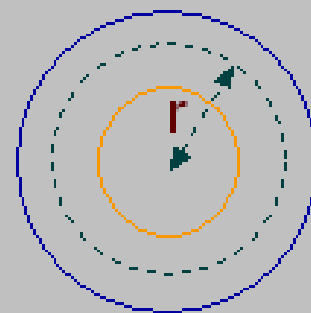
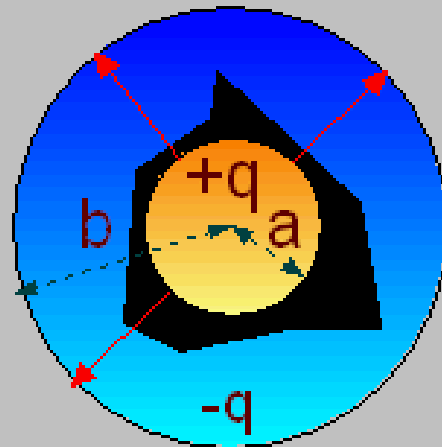
$$\sigma = \frac{q}{A}$$

$$\Phi(\mathbf{E}) = \frac{\sigma \Delta S}{\epsilon_0} = E \Delta S \rightarrow E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

$$\rightarrow V = \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^d E dz = \frac{\sigma d}{\epsilon_0}$$

$$C = \frac{q}{V} = \epsilon_0 \frac{\sigma A}{\sigma d} = \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

# Condensatore sferico



Sup. gaussiana:

$$\Phi(E) = \frac{q}{\epsilon_0} = 4\pi r^2 E \rightarrow E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2}$$

$$V = \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int_a^b E dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_a^b \frac{1}{r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left( -\frac{1}{r} \right) \Big|_a^b$$

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

$$\rightarrow C = \frac{q}{V} = 4\pi\epsilon_0 \frac{1}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}} = 4\pi\epsilon_0 \frac{ab}{b-a}$$